

Спосіб виготовлення детектора іонізуючого випромінювання на основі графенового польового транзистора, за яким наносять плівку відновленого оксиду графену на поверхню шару окисненого поруватого кремнію на кремнієвій підкладці, яку використовують як затвор польового транзистора, формують електричні контакти витоку та стоку на поверхні цієї плівки. У шар поруватого кремнію уводять срібло при проходженні постійного електричного струму 1 мА упродовж 5 с. Шар поруватого кремнію анодно окиснюють у водному розчині пероксиду водню при проходженні постійного електричного струму 20 мА упродовж 1 хв.